

# Silicon Diode

## **BA243**

20V / 100mA

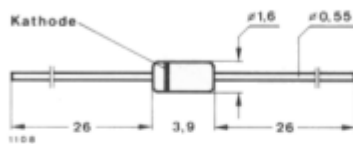
# DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1985

**BA 243 · BA 244****Silizium-Planar-Diode****Anwendungen:** Bereichsumschaltung in VHF-Tunern**Besondere Merkmale:**

- Niedriger differentieller Durchlaßwiderstand im VHF-Bereich
- Kleine Diodenkapazität

**Abmessungen in mm**

Normgehäuse  
54 A 2 DIN 41 880  
JEDEC DO 35  
Gewicht max. 0,15 g

**Bestempfung:** Klartext**Absolute Grenzdaten**

Sperrspannung	$U_R$	20	V
Durchlaßstrom	$I_F$	100	mA
Sperrschichttemperatur	$T_j$	150	°C
Lagerungstemperaturbereich	$T_{stg}$	- 55... + 150	°C

**Wärmewiderstand**

		Min.	Typ.	Max.	
Sperrschicht-Umgebung $l = 4 \text{ mm}, T_L = \text{konstant}$	$R_{thJA}$			350	K/W

**Kenngrößen** $T_j = 25 \text{ °C}$ 

Durchlaßspannung $I_F = 100 \text{ mA}$	$U_F$		1	V	
Sperrstrom $U_R = 15 \text{ V}$	$I_R$		100	nA	
Diodenkapazität $U_R = 15 \text{ V}, f = 100 \text{ MHz}$	$C_D$		1,3	2	pF
Serieninduktivität	$L_s$		2,5		nH
Differentieller Durchlaßwiderstand $I_F = 10 \text{ mA}, f = 200 \text{ MHz}$	$r_f$		0,7	1	Ω
	$r_f$		0,4	0,5	Ω